

	华晶分立器件	3DG6511
高频放大环境额定双极型晶体管		

1 概述与特点

3DG6511 硅 NPN 型高频高压小功率晶体管, 主要用于彩色电视机帧输出和伴音输出。其特点如下:

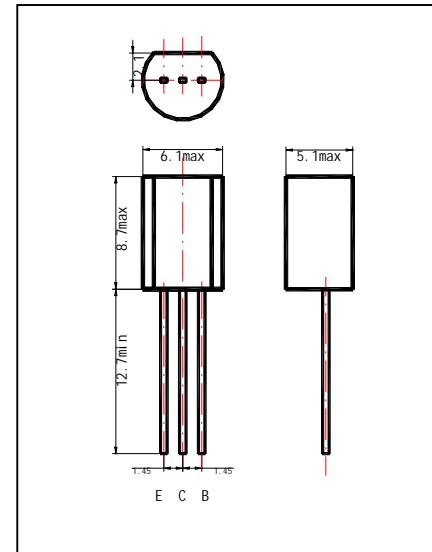
- 击穿电压高
- 饱和压降低
- 电流容量大
- 封装形式: TO-92MOD

2 电特性

2.1 限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压	V_{CEO}	160	V
集电极-基极电压	V_{CB0}	160	V
发射极-基极电压	V_{EB0}	6	V
集电极电流	I_C	1.0	A
耗散功率($T_a=25^{\circ}C$)	P_{tot}	0.9	W
结温	T_j	150	$^{\circ}C$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$



2.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=150V, I_E=0$			1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=6V, I_C=0$			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5V$ $I_C=200mA$	R	60		120
			O	100		200
			Y	160		320
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=500mA, I_B=50mA$			0.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=200mA$ $f=10MHz$	20			MHz
共基极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$			35	pF

无锡华晶微电子股份有限公司

地址:江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话:(0510)5807228-2268、2299 传真:(0510)5800360

3 特性曲线

